Bài số 6

KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CỦA DIODE VÀ TRANSISTOR

| Trường | Xác nhận của giáo viên hướng dẫn | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lớp | | | | | | | | | |
| Họ tên | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I. MỤC ĐÍCH TH | HÍ NGHIỆM | | | | | | | | |
| Khảo sát đặc tính của Diode và Transis | stor | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| II. KẾT QUẢ TH | HI NGHIEM | | | | | | | | |

1. Kết quả đo

A. Diode

| Bảng 1 Thang | g đo | I _t = | 1 10 50 | . (mA) | | , | $\delta V = \dots$ $\delta A_1 = \dots$ $\delta A_2 = \dots$ | 1,5 | (%) | | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|---------------|---------|-----|-----|--|------|------|------|-----|------|------|------|
| Chiều thuận | U (V) | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | 0,64 | 0,69 | 0,72 |
| | l (mA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 3 | 5,2 | 9 | 10 |
| Chiều nghịch | U (V) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | (mA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

B. Transistor

| Bảng 2 Thang | $U_m =1;10(V)$ $I_1 =50(\mu A)$ $I_2 =10(mA)$ | | | | | | $\delta A_1 =$ | $\delta V =1,5\%$ $\delta A_1 =1,5\%$ $\delta A_2 =1,5\%$ | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------|------|------|------|----------------|---|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| I _B = 10μΑ | U _{CE} (V) | 0 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 | 3 |
| | I _C (mA) | 0 | 0,08 | 0,34 | 1,2 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| I _B = 20μΑ | U _{CE} (V) | 0 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 | 3 |
| | I _C (mA) | 0 | 0,16 | 0,92 | 2,2 | 4 | 5 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| I _B = 30μΑ | U _{CE} (V) | 0 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 2 | 3 |
| | I _C (mA) | 0 | 0,24 | 1,6 | 4,2 | 6,4 | 7,6 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| I _B = 40μΑ | U _{CE} (V) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I _C (mA) | | | | | | | | | | | | | | | | |

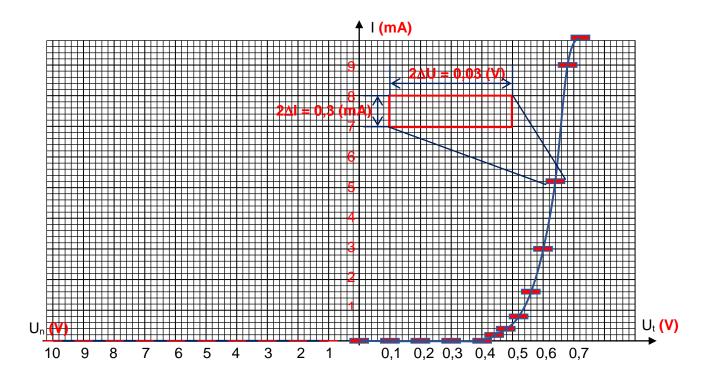
2. Vẽ đồ thị đặc trưng Von – Ampe của Diode I = f (U)

Chú ý: Các số đo của U và I đều có sai số là Δ U và Δ I nên mỗi điểm vẽ của đường đực trưng tương ứng với một cặp số của U và I đều phải biểu diễn bằng một hình chữ nhật có tâm là tọa độ (U,I) và độ dài mỗi cạnh là 2 Δ U và 2 Δ I, với Δ U và Δ I được xác định như sau:

$$\Delta U = U_{m}.\delta V =1x0,015..... =0,015... (V)$$

$$\Delta I_{1} = I_{1m}.\delta A_{1} =10x10^{-3}x0,015.... =1,5x10^{-4}.... (A) = 0,15 (mA)$$

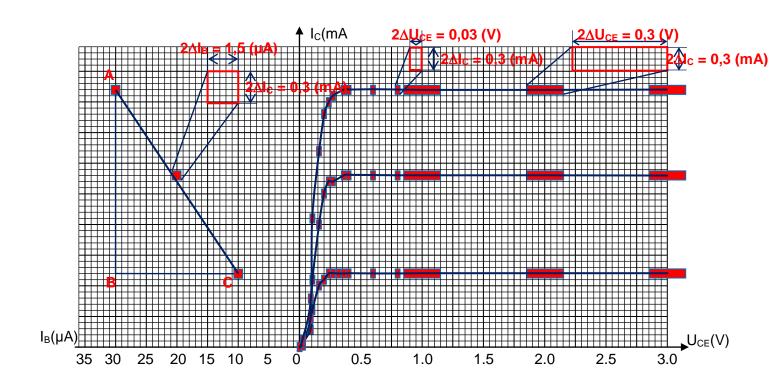
$$\Delta I_{2} = I_{2m}.\delta A_{2} =50x10^{-6}x0,015.... =7,5x10^{-7}.... (A) = 0,75 (\mu A)$$



Kích thước ô sai số:

- Với đồ thị chiều thuận: Trục U_t được đo với đồng hồ có thang đo là **1 V**, vì vậy kích thước chiều ngang ô sai số bằng **1x0,015x2 = 0,03 (V)**. Trục I đô với đồng hồ có thang đo là **10 mA**, vì vậy kích thước chiều cao ô sai số bằng **10x0,015x2 = 0,3 (mA)**.
- Với đồ thị chiều ngược: Không cần biểu diễn ô sai số vì hai lý do. Lý do thứ nhất là các đại lượng I tương ứng của đặc trưng I-V đều bằng **0**, lý do thứ hai là thang đo của đồng hồ đo rất nhỏ (**μA**), mà trục tung hai bên là như nhau, nên không thể biểu diễn được chiều cao ô sai số. Nếu các bạn biểu diễn ô sai số thì nó sẽ là đường nét liền nằm ngang (dài 0,3 V).

3. Vẽ đồ thị đặc trưng Von – Ampe của Transistor $I = f(U_{CE})$ và đặc tính $I_C = f(I_B)$



Kích thước ô sai số:

- Trong phần đo đặc tính I-V chúng ta sử dụng hai thang đo ứng với dải đo U_{CE} khác nhau. Khi U_{CE} nhỏ hơn **1V** thì dùng thang **1 V** và khi đó kích thước chiều rộng ô sai số bằng **1x0,015x2 = 0,03 V**. Khi U_{CE} lớn hơn **1V** thì dùng thang **10 V** và khi đó kích thước chiều rộng ô sai số bằng **10x0,015x2 = 0,3 V**. Đối với thang đo I_C bài xử lý này dung 1 thang duy nhất là **10 mA** nên chiều cao các ô sai số đều bằng **1x0,015x2 = 0,03 mA**. Tóm lại phần đồ thị phía bên phải có hai dạng ô sai số, **các bạn chú ý**.
- Phần đồ thị phía bên trái dung để tính hệ số khuếch đại dòng của transistor. Kích thước chiều cao ô sai số bằng với chiều cao các ô sai số ở đồ thị bên phải trục tung. Chiều rộng ô sai số biểu diễn cho dòng I_B với thang đo **50μA**, kích thước nó bằng **50x0,015x2 = 1,5μA**.

Hệ số khuếch đại dòng của Transistor:
$$\beta = \text{tg } \alpha = \dots \text{AB/BC} \dots = \frac{I_C(A) - I_C(B)}{I_B(B) - I_B(C)} = \frac{8.4 - 2.4}{30 - 10} \cdot \frac{10^{-3}}{10^{-6}} = 300$$